

## Список основных публикаций оппонента **Петрова Александра Сергеевича**

по теме диссертации

1. Брунков П.Н., Ильинская Н.Д., Карандашев С.А., Латникова Н.М., Лавров А.А., Матвеев Б.А., Петров А.С., Ременный М.А., Севостьянов Е.Н., Стусь Н.М., Усикова А.А., «ФОТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ОДИНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР С АКТИВНЫМИ ОБЛАСТЯМИ ИЗ INAS И INASSB», В сборнике: Труды XXIII Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения 2014. С. 250-253.
2. Brunkov P.N., Il'inskaya N.D., Karandashev S.A., Latnikova N.M., Lavrov A.A., Matveev B.A., Petrov A.S., Remennyi M.A., Sevostyanov E.N., Stus N.M., «P-INASSBP/N0-INAS/N+-INAS PHOTODIODES FOR OPERATION AT MODERATE COOLING (150-220 K)», Физика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 10. С. 1394-1397.
3. Ильинская Н.Д., Карандашев С.А., Латникова Н.М., Лавров А.А., Матвеев Б.А., Петров А.С., Ременный М.А., Севостьянов Е.Н., Стусь Н.М., «ОХЛАЖДАЕМЫЕ ФОТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ОДИНОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ II ТИПА P-INASSBP/N-INAS», Письма в Журнал технической физики. 2013. Т. 39. № 18. С. 45-52.
4. Матузов А.В., Афанасьев А.В., Ильин В.А., Кривошеева А.Н., Логинов Б.Б., Лучинин В.В., Петров А.С., «ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СЭНДВИЧ-СТРУКТУРА 3С-SiC/Si, СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННОГО ТИПА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ», патент на изобретение RU 2395867 06.10.2008
5. Ильин В.А., Казак-Казакевич А.З., Матузов А.В., Петров А.С., «МЕТОДИКА ЭПИТАКСИАЛЬНОГО НАРАЩИВАНИЯ КУБИЧЕСКОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ НА КРЕМНИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ CVD», Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2007. № 3. С. 22-25.
6. Айнбунд М.Р., Васильев И.С., Вилькин Е.Г., Забелина Л.Г., Левина Е.Е., Пашук А.В., Петров А.С., Русанова Т.А., Степанов Р.М., Суриков И.Н., «НОВЫЕ ФОТОКАТОДЫ УФ- И ИК-ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ», Прикладная физика. 2006. № 4. С. 97-101.